

$V_{DS} = -20V$

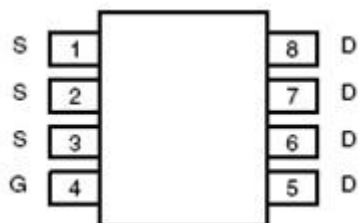
$R_{DS(ON)}, V_{GS}@-4.5V, I_{DS}@-3.0A = 68m\Omega@TYP$

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@-2.5V, I_{DS}@-2.5A = 90m\Omega@TYP$

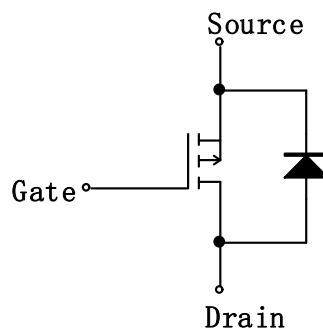
## 特点

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计
- 改良的成型工艺

## 封装图: SOP-8



## 内部结构示意图



## P-Channel MOSFET

## 最大额定值和热特性 (TA=25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	$V_{DS}$	-20	V
栅源电压	$V_{GS}$	±12	
漏极电流	$I_D$	-4	A
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	-12	
工作结温和存储温度范围	$T_J, T_{stg}$	-55 to 150	°C

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。



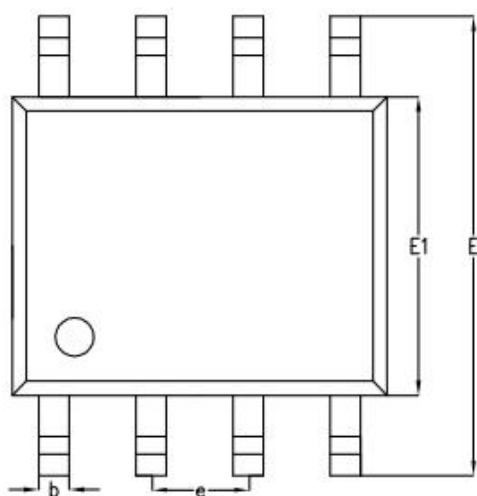
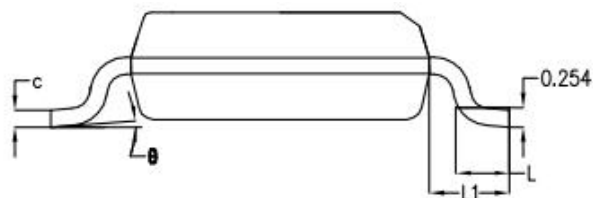
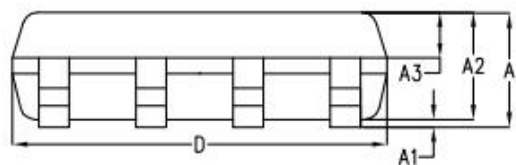
## 电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>静电</b>						
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-20	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -2.5V, I_D = -2.5A$	--	90.0	110.0	mΩ
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -3A$	--	68.0	90.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-0.45	-0.80	-1.1	V
栅源短路时漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = -20V, V_{GS} = 0V$	--	--	-1	uA
漏极短路时截止栅电流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 12V, I_{DS} = 0V$	--	--	±100	nA
<b>漏源二极管</b>						
二极管最大正向电流	$I_S$	--	--	--	-4.0	A
二极管正向电压	$V_{SD}$	$I_S = -1A, V_{GS} = 0V$	--	--	-1.2	V



#### 封装信息

#### SOP-8



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°